

UN SEMPLICE RICEVITORE PER ONDE CORTE

di Giacomin Cristian

Si vede subito dallo schema elettrico la semplicità del circuito, ma vi assicuro che funziona benissimo!

Questo RX O.C. non ha rumore di fondo ed è privo di reazione. Assomiglia molto alla radio a galena, perché il volume d'ascolto varia con l'intensità del segnale dell'emittente.

Non vi sono particolari indicazioni per realizzarlo; serve un cond. Variabile che può esser recuperato da una vecchia radio o acquistato su qualche mercatino o fiera; pochi altri componenti di facile reperibilità.

Non serve un circuito stampato, come si vede dalle foto. Il pot. Da 220 k va regolato per un ascolto ottimale, può essere usato anche come volume. L'antenna può esser di un metro o dieci metri, dipende dalla propagazione del momento, io ne ho messa una interna alla scatola dell'rx, e quando c'è una buona propagazione, è più che sufficiente. Viceversa se la propagazione è scarsa, serve un'antenna a filo di circa 10 metri.

La sensibilità è buona, la selettività dipende dalla zona in cui lavora il C. variabile e dalla lunghezza dell'antenna. Il ricevitore ha i suoi limiti ma, a volte è divertente ascoltare emittenti lontane e capita anche che trasmettano notizie in italiano; da Capodistria credo...

La bobina va avvolta su un cilindro di plastica del diametro di 25 mm circa, ed è composta da dieci spire di filo di rame smaltato del diametro di un millimetro.

L'altoparlante può essere da 4 Om o 8 Om, meglio da 8 ma usate quello che avete in casa.

Per l'alimentazione non c'è problema, funziona da 9 a 25 V.c.c. , io ho usato un trasformatore da 15 V.C.A. 2 V.A. ma possono andare bene anche 2 pile da 9V, oppure una T.R. da 12 V.C.A., un ponte a diodi e un condensatore di livellamento da 4700 microF 35V.

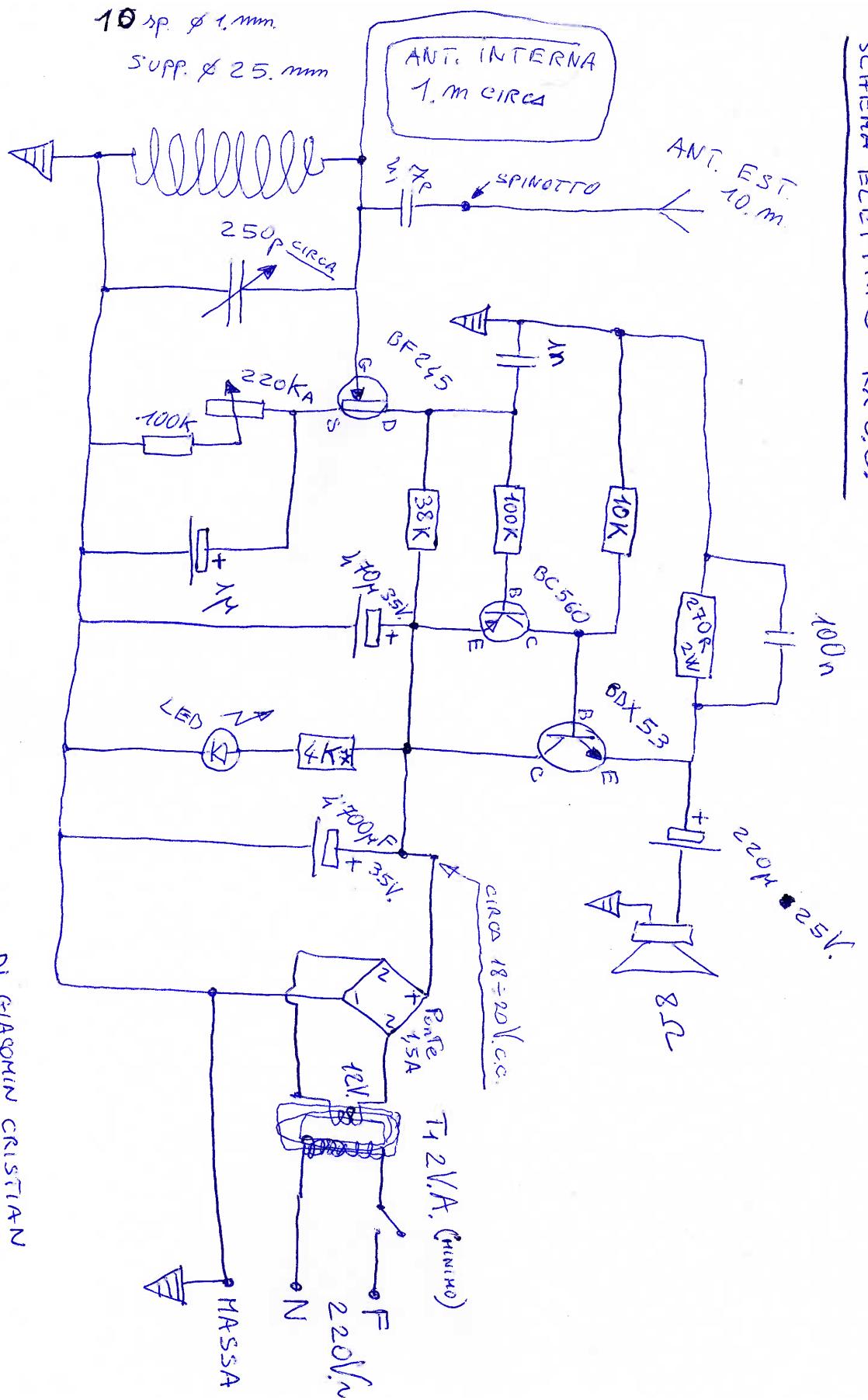
Se vi piace sperimentare nell'elettronica, questo è un buon progetto per fare esperienza.

Qui di seguito troverete le foto della mia realizzazione, lo schema elettrico del ricevitore e dell'alimentatore.

Ringrazio chi mi aiutato a pubblicare il progetto su "Le radio di Sophie" e auguro a tutti una buona sperimentazione.

Cristian Giacomin

SCHEMA ELETTRICO RX O.C.



DI GIAOMIN CRISTIAN

PNP general purpose transistors

BC559; BC560

FEATURES

- Low current (max. 100 mA)
- Low voltage (max. 45 V).

APPLICATIONS

- General purpose switching and amplification.

DESCRIPTION

PNP transistor in a TO-92; SOT54 plastic package.
NPN complements: BC549 and BC550.

PINNING

PIN	DESCRIPTION
1	emitter
2	base
3	collector

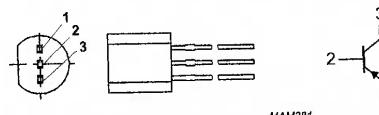


Fig.1 Simplified outline (TO-92; SOT54) and symbol.

QUICK REFERENCE DATA

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_{CBO}	collector-base voltage BC559	open emitter	–	–30	V
	BC560				
V_{CEO}	collector-emitter voltage BC559	open base	–	–30	V
	BC560				
I_{CM}	peak collector current		–	–200	mA
P_{tot}	total power dissipation	$T_{amb} \leq 25^\circ\text{C}$	–	500	mW
h_{FE}	DC current gain	$I_C = -2 \text{ mA}; V_{CE} = -5 \text{ V}$	125	800	
f_T	transition frequency	$I_C = -10 \text{ mA}; V_{CE} = -5 \text{ V}; f = 100 \text{ MHz}$	100	–	MHz



BDX53B / BDX53C BDX54B / BDX54C

COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS

- STMicroelectronics PREFERRED
SALESTYPES

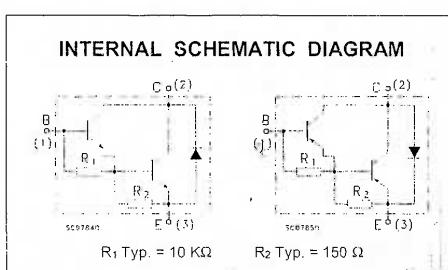
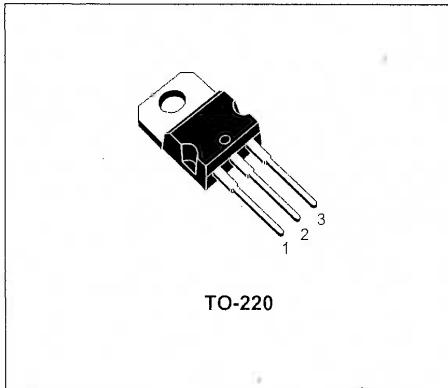
APPLICATIONS

- AUDIO AMPLIFIERS
- LINEAR AND SWITCHING INDUSTRIAL
EQUIPMENT

DESCRIPTION

The BDX53B and BDX53C are silicon Epitaxial-Base NPN power transistors in monolithic Darlington configuration mounted in Jedec TO-220 plastic package. They are intended for use in hammer drivers, audio amplifiers and other medium power linear and switching applications.

The complementary PNP types are BDX54B and BDX54C respectively.



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value			Unit
		NPN	BDX53B	BDX53C	
	PNP	BDX54B	BDX54C		
V_{CBO}	Collector-Base Voltage ($I_E = 0$)	80	100	100	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	80	100	100	V
V_{EB0}	Emitter-base Voltage ($I_C = 0$)	5	5	5	V
I_C	Collector Current	8	8	8	A
I_{CM}	Collector Peak Current (repetitive)	12	12	12	A
I_B	Base Current	0.2	0.2	0.2	A
P_{tot}	Total Dissipation at $T_c \leq 25^\circ\text{C}$	60	60	60	W
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 150	-65 to 150	-65 to 150	$^\circ\text{C}$
T_j	Max. Operating Junction Temperature	150	150	150	$^\circ\text{C}$

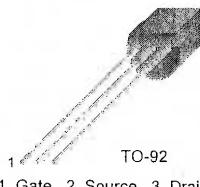
For PNP types voltage and current values are negative.

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR®

BF245A/BF245B/BF245C

N-Channel Amplifiers

- This device is designed for VHF/UHF amplifiers.
- Sourced from process 50.



BF245A/BF245B/BF245C

Absolute Maximum Ratings $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V_{DG}	Drain-Gate Voltage	30	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	-30	V
I_{GF}	Forward Gate Current	10	mA
P_D	Total Device Dissipation @ $T_A=25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	350 2.8	mW mW/ $^\circ\text{C}$
$T_{JL/STG}$	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 ~ 150	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Max.	Units
Off Characteristics					
$V_{(BR)GSS}$	Gate-Source Breakdown Voltage	$V_{DS} = 0$, $I_G = 1\mu\text{A}$	-30		V
V_{GS}	Gate-Source BF245A BF245B BF245C	$V_{DS} = 15\text{V}$, $I_D = 200\mu\text{A}$	-0.4 -1.6 -3.2	-2.2 -3.8 -7.5	V
$V_{GS(\text{off})}$	Gate-Source Cut-off Voltage	$V_{DS} = 15\text{V}$, $I_D = 10\text{nA}$	-0.5	-8	V
I_{GSS}	Gate Reverse Current	$V_{GS} = -20\text{V}$, $V_{GS} = 0$		-5	nA
On Characteristics					
I_{DSS}	Zero-Gate Voltage Drain Current BF245A BF245B BF245C	$V_{GS} = 15\text{V}$, $V_{GS} = 0$	2 6 12	6.5 15 25	mA
g_{fs}	Common Source Forward Transconductance	$V_{GS} = 15\text{V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1\text{KHz}$	3	6.5	mmhos



